

首页 > 传媒扫描

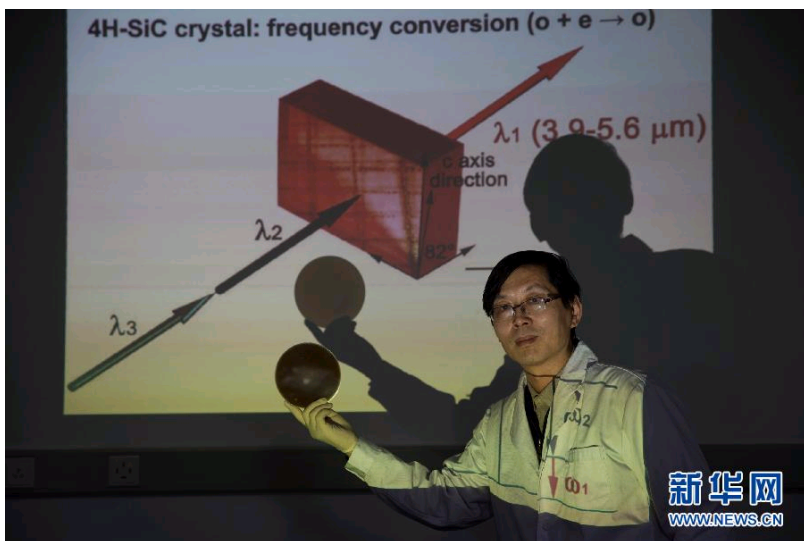
【新华网】中科院成功自主研发6英寸碳化硅单晶衬底

文章来源：新华网 发布时间：2014-12-18 【字号：小 中 大】

我要分享



科研人员在测量6英寸碳化硅单晶衬底的尺寸（12月9日摄）。



中国科学院物理研究所陈小龙研究员在一幅演示碳化硅物理原理的图表前展示6英寸碳化硅单晶衬底（12月17日摄）。新华社记者 金立旺 摄

近日，中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室（筹）先进材料与结构分析实验室团队人员与北京天科合达蓝光半导体有限公司合作，成功研制出了6英寸碳化硅（SiC）单晶衬底。据悉，碳化硅属于第三代半导体材料，是制造高亮度LED、电力电子功率器件以及射频微波器件的理想衬底。

附件：

热点新闻

中科院党组2014年冬季扩大会议召开

- 中科院“率先行动”计划组织实施方案
- 中科院7个科教融合卓越中心通过咨询论证
- 中科院召开境外科教机构建设与发展研讨会
- 《学习时报》专访白春礼：择天下英才而...
- 中科院与中国气象局签署科技合作备忘录

视频推荐



【2014科技盛典】中央电视台年度科技创新人物颁奖典礼

专题推荐



相关新闻

